

Varicap Diode

BA112

80..120pF

DATASHEET

OEM – ITT Intermetall

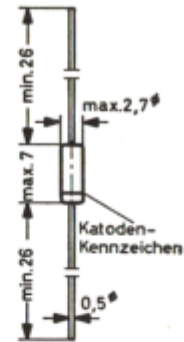
Source: ITT Intermetall Databook 71/72

BA 110, BA 111, BA 112

Diffundierte Silizium-Kapazitätsdioden
für elektronische Abstimm- und Nachstimm-schaltungen

Glasgehäuse JEDEC DO-7
51 A 2 nach DIN 41 880
Gewicht ca. 0,2 g
Maße in mm

In listenmäßiger Ausführung werden
diese Dioden gegurtet geliefert.
Näheres siehe unter „Gurtung“.



Grenzwerte

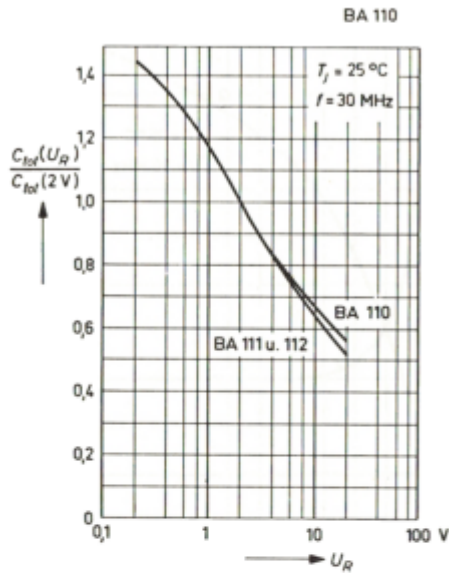
Sperrschichttemperatur	T_j	150	°C
Lagerungstemperaturbereich	T_s	-50...+150	°C

Kennwerte bei $T_j = 25\text{ °C}$

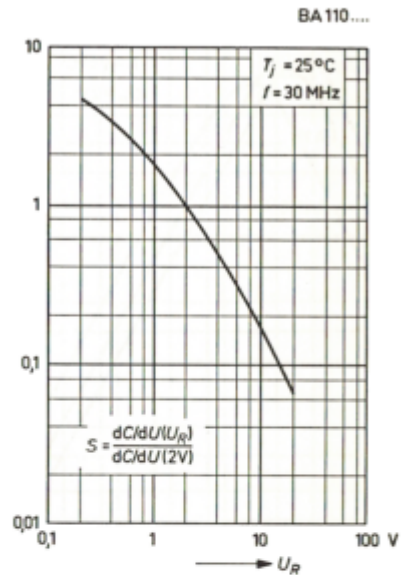
		BA 110	BA 111	BA 112		
Kapazität bei $f = 30\text{ MHz}$, $U_R = 2\text{ V}$	C_{tot}	10 (8...12)	55 (45...65)	100 (80...120)	pF	
	$U_R = 4\text{ V}$	C_{tot}	8,3	45,7	83	pF
	$U_R = 10\text{ V}$	C_{tot}	6,8	34,7	63	pF
Serienwiderstand bei $f = 30\text{ MHz}$, $U_R = 2\text{ V}$	r_s	1	0,5	0,5	Ω	
Güte bei $f = 30\text{ MHz}$, $U_R = 2\text{ V}$	Q	540	200	100		
Durchlaßspannung bei $I_F = 60\text{ mA}$	U_F	0,85 (<0,95)	0,85 (<0,95)	0,85 (<0,95)	V	
Sperrstrom bei $U_R = 10\text{ V}$	I_R	<50	<100	<200	nA	
Durchbruchspannung	$U_{(BR)R}$	>30	>20	>20	V	

BA 110, BA 111, BA 112

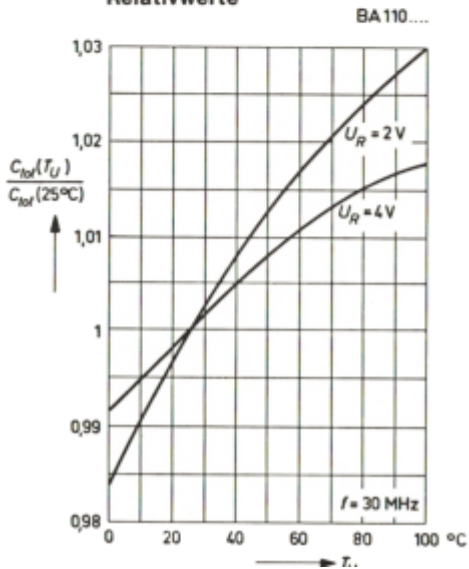
**Kapazität
in Abhängigkeit von der
Sperrspannung
Relativwerte**



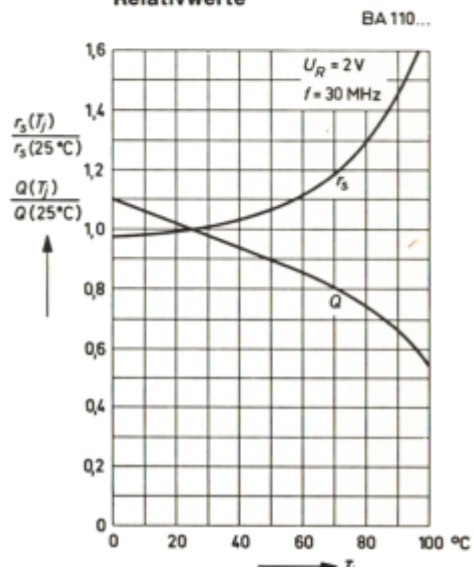
**Steilheit
in Abhängigkeit von der
Sperrspannung
Relativwerte**



**Kapazität
in Abhängigkeit von der
Umgebungstemperatur
Relativwerte**

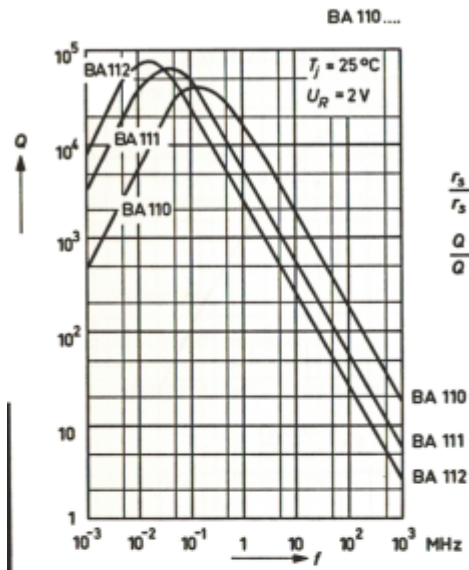


**Serienwiderstand und Güte
in Abhängigkeit von der
Sperrschichttemperatur
Relativwerte**



BA 110, BA 111, BA 112

Güte
In Abhängigkeit von der
Frequenz



Serienwiderstand und Güte
in Abhängigkeit von der
Sperrspannung
Relativwerte

